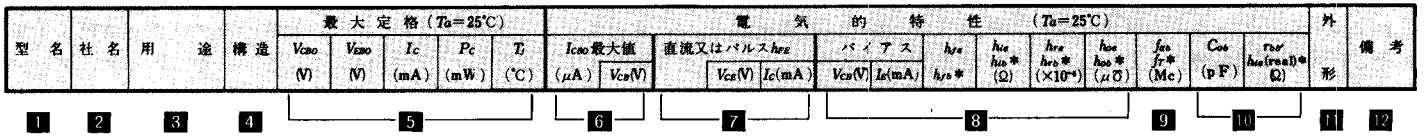
FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS:

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.



1 TYPE NUMBER

2 ORIGINAL MANUFACTURER

3 USES

4 MATERIAL AND STRUCTURE

5 MAXIMUM RATINGS

6 I_{CBO} MAXIMUM VALUE AND V_{CB} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{CBO})

7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{CE} , I_C (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})

8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{CB} , I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

* INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.

9 $f_{\alpha b}$ OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T.

10 C_{ob} AND $r_{bb'}$ OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN $r_{bb'}$ COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (real)

11 OUTLINE

12 REMARKS

:とコンプリ: COMPLEMENTARY TO ·····

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C)					電気的特性 (T_a = 25°C)												外形	備考
					V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流又はパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	バイアス I_E(mA)	h_{fe} / h_{fb}*	h_{ie} / h_{ib}* (Ω)	h_{re} / h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} / h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} / f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ / h_{ie}(real)* (Ω)		
★	2SC1931	富士通	Diff	Si. EP	16	3	30	150/unit	175	0.1	10	80	3	10	6	−20	ΔV_{BE}<20mV, $\gamma\Delta V_{BE}$<60μV/°C (3 V, 10mA)				8000*	0.45	50 *	263	
												h_{FE1}/h_{FE2}=0.6~1.0													
★	〃 1932	〃	〃	〃	16	3	30	200/unit	175	0.1	10	80	3	10	6	−20	ΔV_{BE}<20mV, $\gamma\Delta V_{BE}$<60μV/°C (3 V, 10mA)				8000*	0.45	50 *	264A	
												h_{FE1}/h_{FE2}=0.6~1.0													
	〃 1933	〃	〃	〃	15	3	40	200/unit	175	0.1	10	80	3	10	6	−20	ΔV_{BE}<20mV, $\gamma\Delta V_{BE}$<60μV/°C (6 V, 20mA)				6000*	0.65	50 *	263	
												h_{FE1}/h_{FE2}=0.6~1.0													
	〃 1934	〃	〃	〃	20	3	80	500/unit	175	0.1	10	80	5	30	6	−30	ΔV_{BE}<30mV, $\gamma\Delta V_{BE}$<60μV/°C (5 V, 30mA)				6000*	0.9	50 *	285	
												h_{FE1}/h_{FE2}=0.6~1.0													
★	〃 1935	〃	RF	〃	15	3	30	250	175	0.1	10	80	6	10	6	−20					6000*	0.4	25 *	284	
★	〃 1936	〃	Diff	〃	15	3	30	200/unit	175	0.1	10	80	6	10	6	−20	ΔV_{BE}<20mV, $\gamma\Delta V_{BE}$<60μV/°C (6 V, 10mA)				6000*	0.6	50 *	263	
												h_{FE1}/h_{FE2}=0.6~1.0													
★	〃 1937	〃	RF	〃	15	3	70	300	175	0.1	10	80	6	40	6	−40					6000*	0.7	20 *	284	
	〃 1938	〃	Diff	〃	15	3	30	200/unit	175	0.1	10	80	6	10	6	−20	ΔV_{BE}<20mV, $\gamma\Delta V_{BE}$<60μV/°C (6 V, 10mA)				6000*	0.6	50 *	264B	
												h_{FE1}/h_{FE2}=0.6~1.0													
★	〃 1939	〃	〃	〃	15	3	30	200/unit	175	0.1	10	80	6	10	6	−20	ΔV_{BE}<20mV, $\gamma\Delta V_{BE}$<60μV/°C (6 V, 20mA)				6000*	0.6	50 *	264A	
												h_{FE1}/h_{FE2}=0.6~1.0													
	〃 1940	日電	PA	Si.E	120	5	50	1 W	150	0.1	120	200	10	10	10	−10					120 *	2.3		278	2SA915 とコンプリ
	〃 1941	〃	〃	〃	160	5	50	1 W	150	0.1	160	200	10	10	10	−10					120 *	2.3		278	2SA916 とコンプリ
	〃 1942	日立	SW	Si. T	1500	6	3 A	50W (Tc=25°C)	150	10	600				5	−200	t_f<1 μS				5 *	90	15	102	水平偏向用
	〃 1943	三菱	PA	Si.EP	35	4	400	3 W (Tc=25°C)	175	100	15	50	10	100			P_o=0.4W (f=470MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=30mW)							255	
	〃 1944																								
	〃 1945	三菱	PA	Si.EP	80	5	6 A	20W (Tc=25°C)	150	100	30	50	10	100			P_o=16W, η=70% (f=27MHz, V_{CC}=12V, P_i=0.5W)							301A	
	〃 1946	〃	〃	〃	35	4	7 A	50W (Tc=25°C)	175	2mA	25	50	10	200			P_o=32W, η=70% (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=6W)							272	
	〃 1947	〃	〃	〃	35	4	1 A	10W (Tc=25°C)	175	500	25	50	10	100			P_o=4 W, η=60% (f=175MHz, V_{CC}=13.5V, P_i=0.3W)							84 B	
	〃 1948	日電	RF.LN	Si. E	15	3	20	150	200	1	8	80	8	10	8	−10	G_{pe}=8.5dB (8 V, 10mA, 4 GHz)				8000*	Cre 0.3		339	
	〃 1949	〃	〃	〃	30	3	130	580	200	0.1	20	100	5	50	5	−50	$\lvert S_{21e}\rvert^2$=9.2dB (5 V, 50mA, 1 GHz)				2700*	Cre 1		306	
	〃 1950	〃	RF.PA	〃	28	3	200	5 W (Tc=25°C)	200	0.5	10	40	6	100	6	−100	$\lvert S_{21e}\rvert^2$=4dB (f=1GHz, V_{CE}=6V, I_C=100mA)				4000*	Cre 1.5	25 *	311	
	〃 1951	ソニー	RF	〃	120	5	100	750	120	0.2	100	150	5	3	10	−20	h_{fe}=8dB (f=100MHz)					2.4	$C_c r_{bb'}$ 45pS	259	2SA917 とコンプリ
	〃 1952	日電	RF. LN	〃	45	3	300	800	200	0.1	20	80	10	50	15	−50	G_{pe}=18dB (15V, 50mA, 200MHz)				2000*	2		84B	
	〃 1953	松下	AF.PA		150	5	100	1 W	150	1	100	65~450	5	10	10	−10					200 *			222	2SA914 とコンプリ
	〃 1954	富士通	RF	Si. EP	25	3	150	450	150	1	20	100	10	25	10	−25					1500*	2	35 *	138	
	〃 1955	東芝	PA	〃	35	3.5	800	7.5W (Tc=25°C)	175	1mA	15	>10	5	500			P_O=3.2W (f=175MHz, V_{CE}=13.5V, P_i=0.15W)					<15		84B	
★	〃 1956	〃	〃	〃	35	3.5	3.5A	35W (Tc=25°C)	175	1mA	15	50	5	1 A			P_O=17W (f=175MHz, V_{CE}=12.5V, P_i=1.3W)							135	
	〃 1957	日電	〃	Si.E	75	4	1 A	750	150	1	40	90	10	500	10	−150	P_O=1.8W, η >60% (V_{CC}=12V, f=27MHz, P_i=35mW)				250 *	14	14	225	
	〃 1958																								
	〃 1959	東芝	AF. SW	Si. E	35	5	500	500	150	0.1	35	70~240	1	100	6	−20					300 *	7		138	2SA562 とコンプリ
	〃 1960	富士通	SW	Si. EP	20	4	200	300	150	0.4	15	60	1	10			t_r=4nS, t_f=9nS t_{stg}=6nS							275	